

(China)

EV GROUP BRINGS REVOLUTIONARY LAYER TRANSFER TECHNOLOGY TO HIGH-VOLUME MANUFACTURING WITH EVG®850 NANOCLEAVE™ SYSTEM – December 13, 2023

EV Group today introduced the EVG®850 NanoCleave™ layer release system—the first product platform to feature EVG's revolutionary NanoCleave technology. The EVG850 NanoCleave system enables nanometer-precision release of bonded, deposited or grown layers from silicon carrier substrates using an infrared (IR) laser coupled with specially formulated inorganic release materials in a proven, high-volume-manufacturing (HVM) capable platform.



硅载体有利于3D堆叠和后端处理

在30集成中,玻璃基板已成为通过与有机粘合剂的临时键合来构建器件层的一种吸定方法,使用紫外 线 (UV) 波长激光溶解粘合剂并刺离离件层,然后将器件层永久键合至最终产品均高圆上。然而、半导 体制造设备主要围绕鞋设计,需要进行昂贵的升级才能用于加工玻璃基板。此外,有机粘合剂的加工温度 缩数件平300°C。用此口能用于能域的T

使硅载体具有无机剥离层避免了这些温度和玻璃载体兼容性问题。红外激光还可以达到纳米级切割精 度,能够在不改变记录工艺的前提下加工级薄的器件晶片。这种薄器件层进行后续堆叠,可实现更高带宽 的互连,并为下一代高性能器件设计和芯片分割带来新的机遇。

下一代晶体管节点需要采用薄层转移工艺

此外,3纳米以下节点的晶体管路线圈还要求采用新型架特和设计创新,如埋入式电源机。背面功率输 送网络、互补场效应晶体管(CFET)和20原子通道等。这些都需要对搜索材料进行层块核。硅载体和无 机剥离层能够满足的端射造流程对工艺高洁底、材料兼容性和较高工艺温度的要求。然而。这今为止,硅 载体仍须通过研修、抛光和蚀刻等工艺才能完全去除,导致工作器件层表面出现微米级变化,因此这种方 法不适合在原象节点进行测度理量。

"TRIBUTE OCHORISMO

EVG850 NanoCleave利用红外激光和无机剥离材料,能够在生产环境中以纳米精度对硅载炸进行激光 切割。这种创新工艺无需使用玻璃基板和有机结合剂。实现了超薄层转移,而且能够兼容下游工序的崩竭 工艺。EVG850 NanoCleave兼容高温(最高可达1000°C),支持要求最苛刻的崩竭工艺。室温红外切 割工艺也确保了器件层和载体基板的完整性。层转移工艺还无需使用与载体晶片研磨、抛光和蚀刻相关的 品数溶剂。

EVG850 NanoCleave与EV集团业内领先的EVG850系列自动临时键合/剥离及"绝缘体上硅"(SOI)键合系统基于相同的平台,采用紧凑设计,晶圆处理系统已通过批量生产(HVM)验证。

EV集团研发项目经理Bernd Thallner博士介铅说: "EV集团创办40多年以来始终走在行业前端,坚持 探索新技术、服务于微水和熔水制造技术的下一代应用,近来,30和异构集成已成为想升新一代半导体 器件性能的重要驱动因素,反过来又使晶圆键合成为改进PPACt(切率、性能、面标、成本和上市时间) 的关键工艺。使他新程EVG850 NanoCleave系统,EV集团通过一个多功能平台融合了临时键合和路融键 合的优势,帮助部户在先进封装和下一代微缩晶体管的设计和制造领域扩展未来路线圈。"



免患声明:凡注明来源本网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处。非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞阿其观点和对其真实性负责。



https://info.finance.hczyw.com/2023/1213/23575.html